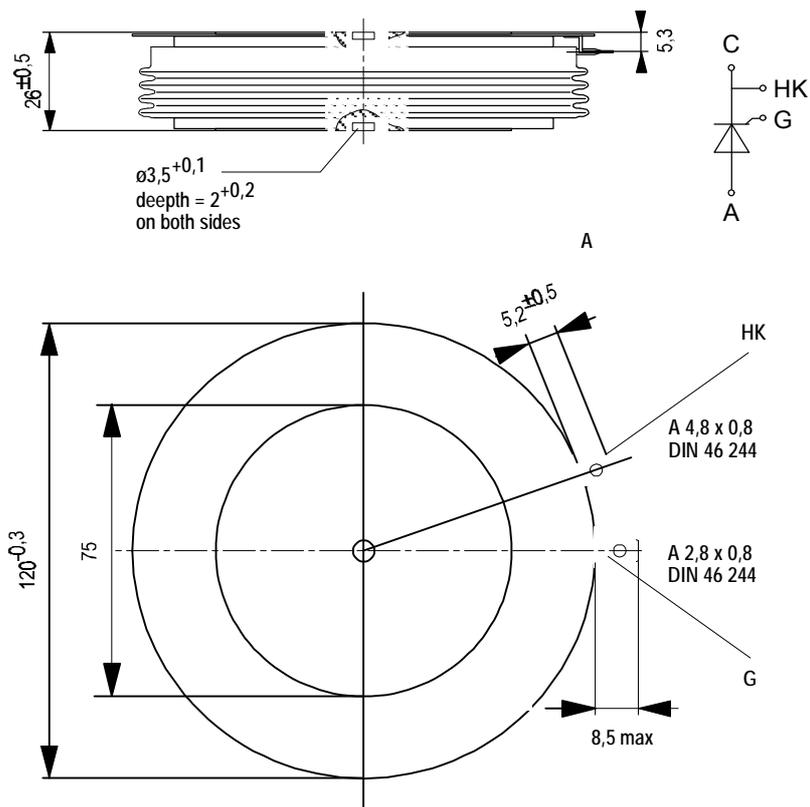


European Power-Semiconductor and Electronics Company

# Marketing Information

## T 2160 N



# T 2160 N

## Elektrische Eigenschaften

### Höchstzulässige Werte

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung

Vorwärts-Stoßspitzensperrspannung

Rückwärts-Stoßspitzensperrspannung

Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom

Stoßstrom-Grenzwert

Grenzlastintegral

Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

## Electrical properties

### Maximum rated values

repetitive peak forward off-state and reverse voltages

non-repetitive peak forward off-state voltage

non-repetitive peak reverse voltage

RMS on-state current

average on-state current

surge current

$I^2 t$ -value

critical rate of rise of on-state current

critical rate of rise of off-state voltage

$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj\text{max}}$

$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj\text{max}}$

$t_{vj} = +25^\circ\text{C} \dots t_{vj\text{max}}$

$t_c = 85^\circ\text{C}$

$t_c = 64^\circ\text{C}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}, t_p = 10 \text{ ms}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}, t_p = 10 \text{ ms}$

DIN IEC 747-6,  $f = 50 \text{ Hz}$ ,  
 $v_L = 10 \text{ V}, i_{GM} = 1,6 \text{ A}, di_G/dt = 1,6 \text{ A}/\mu\text{s}$

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}, V_D = 0,67 V_{DRM}$   
5.Kennbuchstabe/5th letter C

5.Kennbuchstabe/5th letter F

$V_{DRM}, V_{RRM}$

$V_{DSM}$

$V_{RSM}$

$I_{TRMSM}$

$I_{TAVM}$

$I_{TSM}$

$I^2 t$

$(di_T/dt)_{cr}$

$(dv_D/dt)_{cr}$

2000 2200 2400 V<sup>1)</sup>  
2600 2800

2000 2200 2400 V  
2600 2800

2100 2300 2500 V  
2700 2900

4600 A

2159 A

2930 A

44000 A<sup>1)</sup>

40000 A

$9,68 \square 10^6 \text{ A}^2\text{s}$

$8 \square 10^6 \text{ A}^2\text{s}$

150 A/ $\mu\text{s}$

500 V/ $\mu\text{s}$

1000 V/ $\mu\text{s}$

## Charakteristische Werte

Durchlaßspannung

Schleusenspannung

Ersatzwiderstand

Zündstrom

Zündspannung

Nicht zündender Steuerstrom

Nicht zündende Steuerspannung

Haltestrom

Einraststrom

Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom

Zündverzug

Freiwerdezeit

## Characteristic values

on-state voltage

threshold voltage

slope resistance

gate trigger current

gate trigger voltage

gate non-trigger current

gate non-trigger voltage

holding current

latching current

forward off-state and reverse currents

gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}, i_T = 8800 \text{ A}$

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}$

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}, V_D = 6 \text{ V}$

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}, V_D = 0,5 V_{DRM}$

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}, V_D = 0,5 V_{DRM}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_A = 5 \Omega$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_{GK} \geq 10 \Omega$

$i_{GM} = 1,6 \text{ A}, di_G/dt = 1,6 \text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 20 \mu\text{s}$

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}, V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$

DIN IEC 747-6,  $t_{vj} = 25^\circ\text{C}, i_{GM} = 1,6 \text{ A}$ ,

$di_G/dt = 1,6 \text{ A}/\mu\text{s}$

$t_{vj} = t_{vj\text{max}}, i_{TM} = I_{TAVM}, V_{RM} = 100 \text{ V}$ ,  
 $V_{DM} = 0,67 V_{DRM}, dv_D/dt = 20 \text{ V}/\mu\text{s}$ ,  
 $di_T/dt = 10 \text{ A}/\mu\text{s}$ , 4.Kennbuchstabe/4th letter O

$V_T$

$V_{T(TO)}$

$r_T$

$I_{GT}$

$V_{GT}$

$I_{GD}$

$V_{GD}$

$I_H$

$I_L$

$i_D, i_R$

$t_{gd}$

$t_q$

max. 2,65 V

1,05 V

0,154 m $\Omega$

max. 300 mA

max. 300 V

max. 10 mA

max. 5 mA

max. 0,25 V

max. 300 mA

max. 1500 mA

max. 250 mA

max. 300  $\mu\text{s}$

typ. 250  $\mu\text{s}$

## Thermische Eigenschaften

Innerer Wärmewiderstand

Übergangs-Wärmewiderstand

Höchstzul.Sperrschichttemperatur

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

## Thermal properties

thermal resistance, junction to case

thermal resistance, case to heatsink

max. junction temperature

operating temperature

storage temperature

Kühlfläche/cooling surface

beidseitig/two-sided,  $\Theta = 180^\circ \text{ sin}$

beidseitig/two-sided, DC

Kühlfläche/cooling surface

beidseitig/two-sided

einseitig/single-sided

$R_{thJC}$

$R_{thCK}$

$t_{vj\text{max}}$

$t_{c\text{op}}$

$t_{stg}$

0,0099  $^\circ\text{C}/\text{W}$

0,0092  $^\circ\text{C}/\text{W}$

0,0025  $^\circ\text{C}/\text{W}$

0,005  $^\circ\text{C}/\text{W}$

125  $^\circ\text{C}$

-40...+125  $^\circ\text{C}$

-40...+150  $^\circ\text{C}$

## Mechanische Eigenschaften

Si-Element mit Druckkontakt, Amplifying-Gate

Anpreßkraft

Gewicht

Kriechstrecke

Feuchteklasse

Schwingfestigkeit

Gehäuse

## Mechanical properties

Si-pellet with pressure contact, amplifying gate

clamping force

weight

creepage distance

humidity classification

vibration resistance

case

DIN 40040

$f = 50 \text{ Hz}$

F

G

42...95 kN

typ. 1200 g

25 mm

C

50 m/s<sup>2</sup>

Titelseite / front page

<sup>1)</sup> Gehäusegrenzstrom 36 kA (50Hz Sinushalbwellen). / Current limit of case 36 kA (50Hz sinusoidal half-wave).

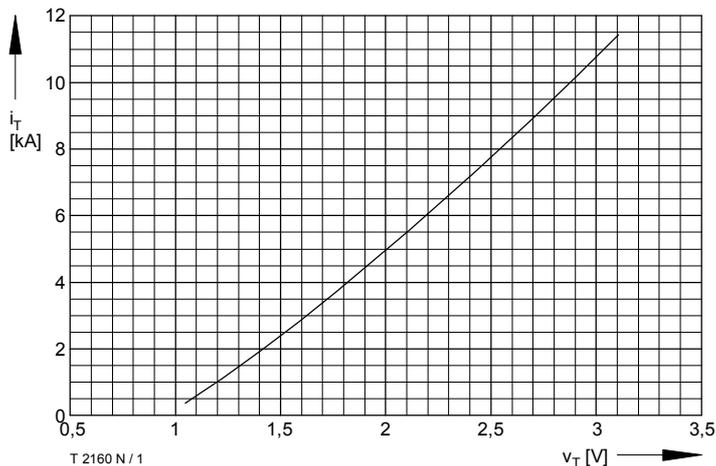


Bild / Fig. 1  
Grenzdurchlaßkennlinie / Limiting on-state characteristic  $i_T = f(v_T)$   
 $t_{vj} = t_{vj \max}$

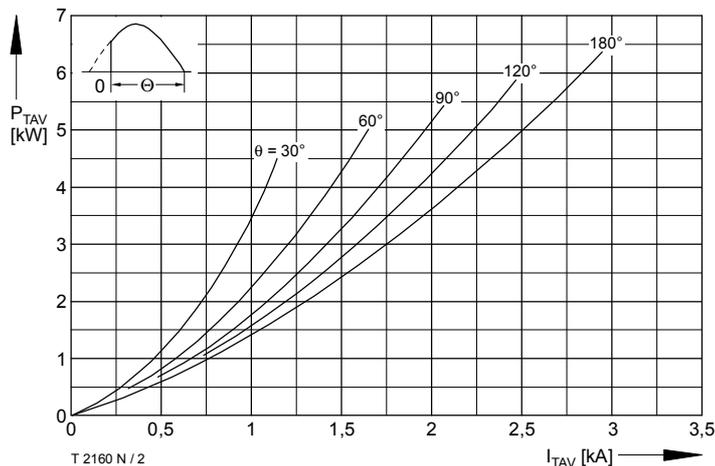


Bild / Fig. 2  
Durchlaßverlustleistung / On-state power loss  $P_{TAV} = f(I_{TAV})$   
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$

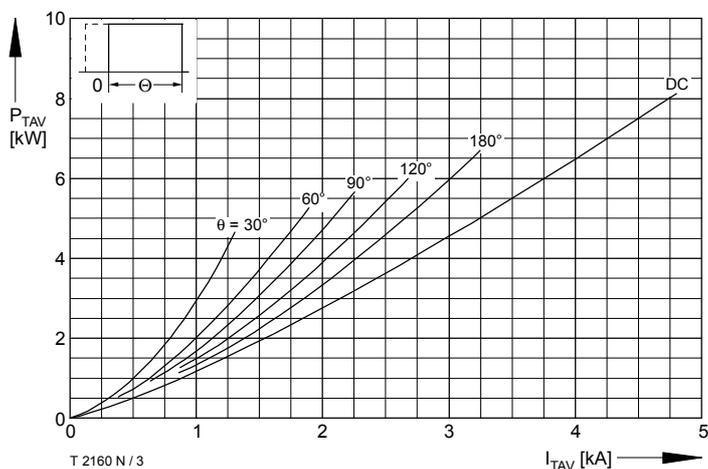


Bild / Fig. 3  
Durchlaßverlustleistung / On-state power loss  $P_{TAV} = f(I_{TAV})$   
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$

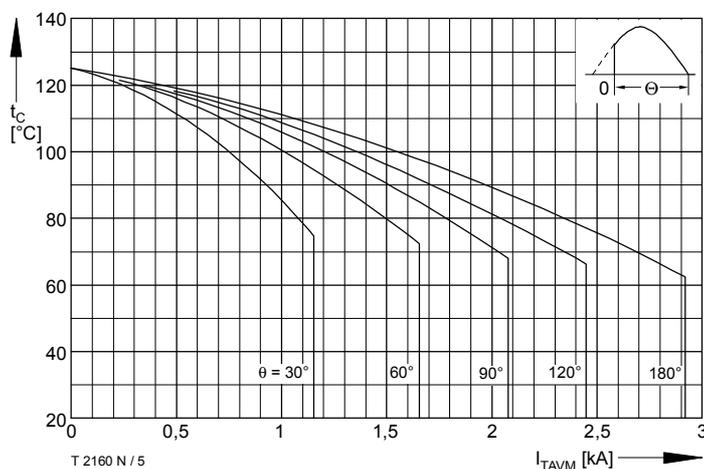


Bild / Fig. 5  
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature  $t_c = f(I_{TAVM})$   
Beidseitige Kühlung / Two sided cooling  
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle  $\theta$   
Berechnungsgrundlage  $P_{TAV}$  (Schaltverluste gesondert berücksichtigen) / Calculation base  $P_{TAV}$  (switching losses should be considered separately)

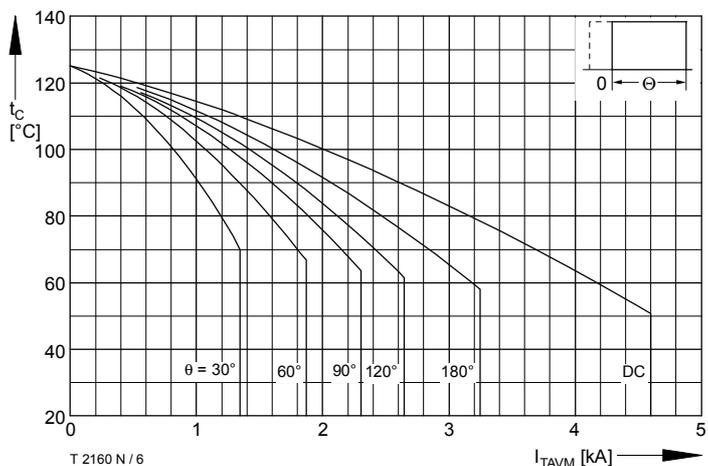


Bild / Fig. 6  
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature  $t_c = f(I_{TAVM})$   
Beidseitige Kühlung / Two sided cooling  
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle  $\theta$   
Berechnungsgrundlage  $P_{TAV}$  (Schaltverluste gesondert berücksichtigen) / Calculation base  $P_{TAV}$  (switching losses should be considered separately)

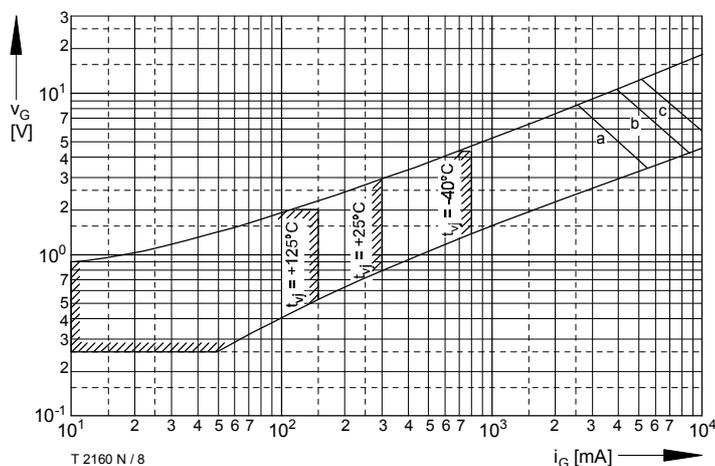


Bild / Fig. 8  
Steuercharakteristik mit Zündbereichen / Gate characteristic with triggling areas  $v_G = f(i_G)$ ,  $V_D = 6 \text{ V}$   
Parameter:

	a	b	c
Steuerimpulsdauer / Puls duration $t_g$ [ms]	10	1	0,5
Höchstzulässige Spitzensteuerleistung / Maximum allowable peak gate power [W]	20	40	60

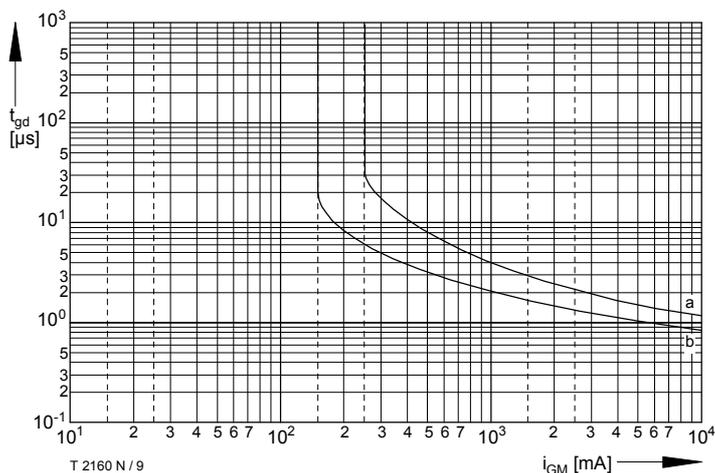


Bild / Fig. 9  
 Zündverzögerung / Gate controlled delay time  $t_{gd} = f(i_{GM})$ ,  $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ ,  
 $di_G/dt = i_{GM}/1\mu\text{s}$   
 a - Maximaler Verlauf / Limiting characteristic  
 b - Typischer Verlauf / Typical characteristic

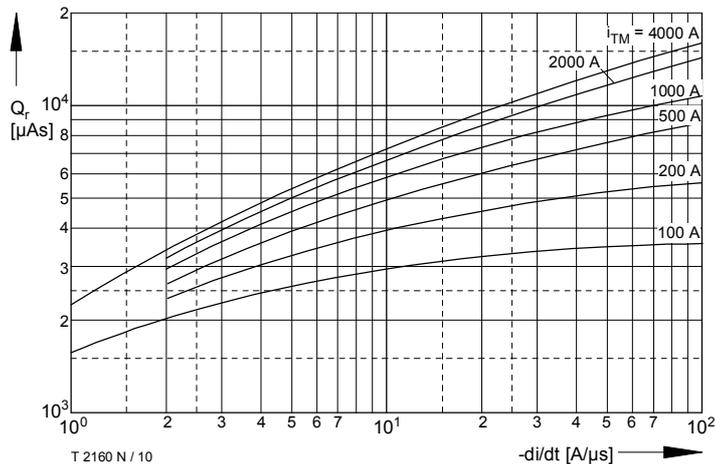


Bild / Fig. 10  
 Sperrverzögerungsladung / Recovered charge  $Q_r = f(di/dt)$   
 $t_{vj} = t_{vj\text{ max}}$ ,  $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$ ,  $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$   
 Parameter: Durchlaßstrom / On-state current  $i_{TM}$

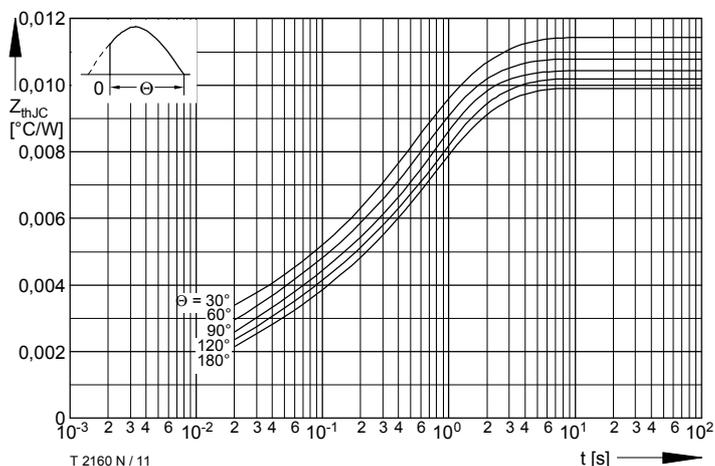


Bild / Fig. 11  
 Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance  
 $Z_{thJC} = f(t)$   
 Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling  
 Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$

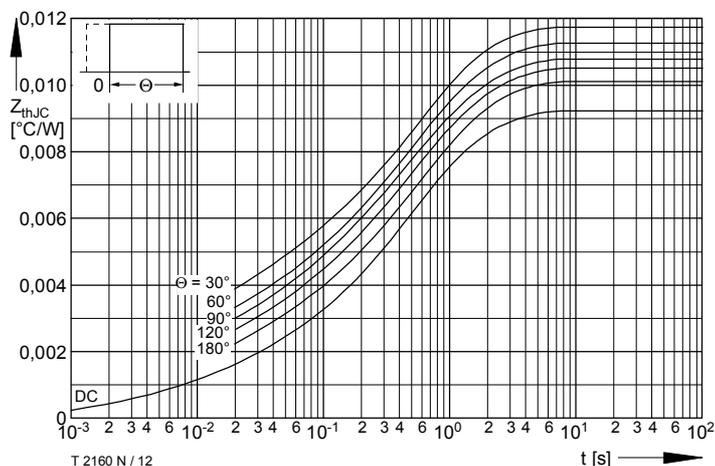


Bild / Fig. 12  
 Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance  
 $Z_{thJC} = f(t)$   
 Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling  
 Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thJC}$  pro Zweig für DC  
 Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thJC}$  per arm for DC

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling

Pos. n	1	2	3	4	5	6
$R_{thn} [^\circ\text{C/W}]$	0,00003	0,00039	0,00123	0,00317	0,00438	
$\tau_n [s]$	0,000055	0,00392	0,0152	0,2068	1,0914	

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$